アゾベンゼンを側鎖に持つポリシランの主鎖構造制御1:可逆性の検討

(群馬大工) 堀内宏明・福嶋超・趙常礼・奥津哲夫・平塚浩士

【序】 ポリシランは Si-Si 主鎖に沿ってσ電子が非局在化した共役高分子であるため、 導電性などを示す。また、炭素系共役高分子とは異なり、単結合からなる主鎖構造は フレキシブルであるため、主鎖構造を変化させることにより導電性などの物性を制御 できる可能性を持つ。我々はこれまでに、側鎖にアゾベンゼン誘導体を導入したポリ シランを合成し、薄膜状態においてアゾベンゼンの *trans* → *cis* 光異性化により、ポリ シラン主鎖構造が helix から random coil へと変化することを報告した (Scheme 1)<sup>1</sup>。本 報告では、このアゾベン

ゼンの異性化反応によ るポリシラン主鎖構造 の変化が可逆的に進行 するかどうかを検討し

た。



Scheme 1. Conformational change of PMPS-azo upon irradiation.

【実験】 試料には poly(methylphenylsilane) (PMPS)の側鎖に nitroazobenzene (azo 基)を導 入した PMPS-azo (Fig.1)を用いた。薄膜作製に はスピンコート法を用いた。光照射には Xe lamp からの光を、分光器により 435 nm の光 を選択して用いた。



Fig. 1 Molecular structure of PMPS-azo.

【結果と考察】 Fig.2a(青線)は PMPS-azo 薄膜の吸収スペクトルを示している。380 nm、340 nm 付近の吸収帯はそれぞれ *trans*-azo 基、および helix 構造を持つポリシラン主鎖によるものである。光照射により両吸収帯が減少し(赤線)、これは azo 基の *trans* → *cis* 光異性化によりポリシラン主鎖構造が helix から random coil へと変化したため である(Scheme 1)。*cis*-アゾベンゼンは光化学的あるいは熱化学的に *trans*-アゾベンゼ ンに戻ることが知られている。そこで、光照射によって構造変化した PMPS-azo 薄膜 を加熱することにより元の構造に戻せるかどうかを検討した。Fig. 2b は光照射後に、

各温度で40分間置いた後に室温まで 冷却した試料について測定した差吸 収スペクトルを示している。80°Cま では加熱により、380 nm 付近の trans-azo による吸収帯の増加のみが 観測された。このことから 80°Cま では一部の cis-azo 基が trans 体に戻 るが、この azo 基の熱異性化はポリ シラン主鎖構造を変化させないこと がわかった。温度を 100°C 以上に上 昇させると、trans-azo 基の吸収帯は 増加しないにもかかわらず、helix 構 造を持つポリシラン主鎖の吸収帯の 増加が観測された。これらの結果か ら、光照射後の PMPS-azo 薄膜を加



Fig.2 Absorption spectral change of PMPS-azo 0.5 observed upon 345-nm light irradiation (a) and difference absorption spectra before and after the irradiation and heating (b).

熱することにより azo 基の *cis* → *trans* 熱異性化と、random coil から helix へのポリシ ラン主鎖の構造変化が起こることがわかった。また、azo 基の構造変化はポリシラン 主鎖の構造変化を誘起しないことがわかった。アゾベンゼン誘導体を導入したポリシ ラン主鎖のガラス転移点は 155 °C と報告されており、温度がガラス転移点に近づく ことによってポリシラン主鎖の構造変化が引き起こされているものと考えられる。 PMPS-azo 薄膜を 140 °C 以上に加熱すると azo 基の熱分解が起こり、これ以上高い温 度での実験はできなかった。120 °C における変換効率は azo 基とポリシラン主鎖でそ れぞれ 80%、60% であると見積もられた(Scheme 2)。



Scheme 2. Conformational change of PMPS-azo upon heating.

<sup>[1]</sup> H. Horiuchi et al., Chem. Lett., in press.